

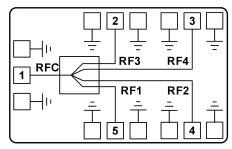
GaAs MMIC 四路功分器, 2 - 18 GHz

主要特点

频率范围: 2-18 GHz 插入损耗: 2.0 dB

输入/输出: 50 Ohm 匹配 芯片尺寸: 3 × 4 × 0.1 mm³

功能框图

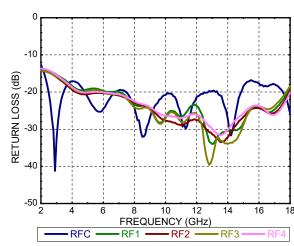


性能指标(T_A = +25 \mathbb{C} , Pin = 0 dBm)

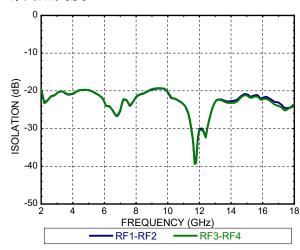
参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 18		GHz	
插入损耗		2.0		dB
平坦度		±1.0		dB
隔离度		25		dB
回波损耗		18		dB

插入损耗 -0.5 -1.0 (gp) SSOJ -2.0 -2.0 -3.5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 FREQUENCY (GHz) -RF1 — RF2 — RF3 — RF4

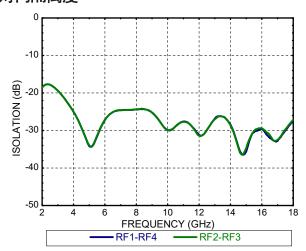
回波损耗



邻向隔离度



对向隔离度



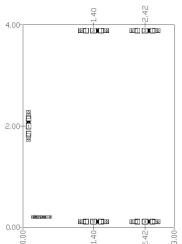
成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室 电话: 17313176116 028-64331356 022-66351597 天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层邮箱: support @higaas.com 网址: www.higaas.com



GaAs MMIC 四路功分器, 2 - 18 GHz

物理参数

单位: mm



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RFC	该焊盘是射频公共端
2	RF3	该焊盘是射频支路端
3	RF4	该焊盘是射频支路端
4	RF2	该焊盘是射频支路端
5	RF1	该焊盘是射频支路端

注意事项

- 1. 本芯片属于静电敏感器件,运输、存储和使用 过程中注意静电防护
- 2. 芯片厚度为 100 um
- 3. 典型键合焊盘尺寸为 120*100 um²
- 4. 键合焊盘金属化: 金
- 5. 芯片背面镀金
- 6. 芯片背面接地
- 7. 未标注的键合焊盘不需要连接
- 8. 钝化层信息: 材质: SiN+PBO; 厚度: 0.5+1.6um

极限参数

- 1. 射频输入功率: +37dBm
- 2. 储存温度: -65~+150℃
- 3. 工作温度: -55~+85℃